# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

# **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## 19日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### 平4-21739 @ 公 開 特 許 公 報 (A)

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)1月24日

C 22 C B 22 F 32/00 1/02 3/00

Ď

7047-4K 8015 - 4 K

8015-4K ×

審査請求 未請求 請求項の数 12 (全17頁)

40発明の名称 複合材料及びその製造方法

> 顧 平2-150990 の特

願 平2(1990)6月8日 29出

②平1(1989)6月9日3日本(JP)3時顯 平1-147902 優先権主張

②平1(1989)7月7日3日本(JP)3時頭 平1-175901

②平1(1989)7月19日30日本(JP)30特額 平1-186488

明 @発 者 红 公 博 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

何発 明 者 @発 明 者

康 菅 谷 井 上

宫

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内 修

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

明 @発 者 廣  $\blacksquare$ 僻

大阪府門真市大字門真1006番地

松下電器産業株式会社内

@発 明 者

男 見 里

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

る。 顐 人 四代 理 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

弁理士 粟野 重孝 外1名

最終頁に続く

明 紐

1. 発明の名称

複合材料及びその製造方法

#### 2. 特許額求の顧囲

(1)無機質で粒子状の第1の物質と、前記第 1の物質とは構成元素もしくは構成イオンの数。 種類あるいは価数又は結晶構造の内の何れかが異 なる無機質の前記第1の物質以外の物質との少な くとも2種の物質から構成された微小粒径複合体 であって、 前記第1の物質以外の物質が前記第1 の物質とは別の相でかつ連続相を形成し、 前記徴 小粒径複合体の気孔率が5%以下であることを特 徴とする複合材料。

- (2)第1の物質以外の物質の平均厚さが、5 □■以上50□■以下であることを特徴とする。 額求 項1記載の複合材料。
- (3)無機質で粒子状の第1の物質の表面を、 前記第1の物質とは構成元素もしくは構成イオン の数、種類あるいは衝数又は結晶構造の内の何れ かが異なる無機質の前記第1の物質以外の物質の

中の少なくとも1種でほぼ覆う被覆工程と、 前記 被理工程の後、前記第1の物質と前記第1の物質 以外の物質の少なくとも2種以上の物質を含む微 小粒径複合体を、 気孔率 5 % 以下の成形体を得る 成形工程を行うことを特徴とする複合材料の製造 方法。

- (4) 第1の物質以外の物質が、超塑性を示す 材料を含有することを特徴とする。請求項3記載 の複合材料の製造方法。
- (5)第1の物質以外の物質が、 焼結助剤を含 育することを特徴とする、 請求項3記載の複合材 科の製造方法。
- (6)焼結助剤が、ほう素、鉛、パナジウム、 ピスマス及びそれらの化合物の内から選ばれる少 なくとも一種以上であることを特徴とした。 胡求 項5記載の複合材料の製造方法。
- (7)被覆工程が、第1の物質を活性ガス中で 処理する工程であることを特徴とする、請求項3 記載の複合材料の製造方法。
  - (8)活性ガスが、窒素を含有することを特徴

とする、顕求項7記載の複合材料の製造方法。

(9) 活性ガスが、酸素を含有することを特徴 とする、顕求項7記載の複合材料の製造方法。

(10)被覆工程が、第1の物質をスパッター処理する工程であることを特徴とする、請求項3 記載の複合材料の製造方法。

(11)被覆工程が、第1の物質の表面にメカニカルアロイングにより、前記第1の物質以外の物質を付着処理する工程であることを特徴とする、 第求項3記載の複合材料の製造方法。

(12) 成形体工程の後、 前記成形体を高温高圧下で無処理し、 気孔率を 3 %以下に高密度化する工程を行うことを特徴とする、 請求項 3 記載の複合材料の製造方法。

# 3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、複合材料及びその製造方法に関し、特に構成材料の内の少なくとも1つの厚みが非常に薄い連続した相で形成された所謂ナノコンポジット材料であり、電子材料や構造材料等の産業分

結着層(連続相)が樹脂であるため剛性が不足すると言う課題があった。

一方 第 7 図に示したような金属技法では、 2 とでは、 2 とでは、 2 とでは、 2 とでは、 3 のでは、 3 ののでは、 4 ののでは、 4 ののでは、 5 ののでは、 5

上述では金属を充填剤としせうミックスを結番 材とした場合であったが、どちらを充填材として も、従来の技術では連続相の量が圧倒的に多い点 と、三角点103が複合体の劣化の原因となる点 の課題があった。

従来の複合体では連続相によって隔離された粒

野に広く応用出来る材料に関する。

従来の技術

世来より材質が相異なる2種以上の粒子を混合 又は粒子と結署材とを混合して結署させ複合体を 形成する技術が知られており、 連続相中に異の 粒子の含まれた複合体が知られている。 即ち例え ばセラミックスもしくは金属と樹脂、 又は 専り ックスと金属との複合体は、 耐熱性、 熱伝導性、 迷焼性、 強度あるいは比重等を改良する手法とし て提案されたものである。

これらの複合体に於て、 前者は剛性の低い複合体であり、 後者は高剛性複合体が報告されている。 即ち第7 図に示したように、 金属粒子101とセラミックス層102とを、 均一に混合しただけの複合体である。

発明が解決しようとする課題

しかし樹脂とセラミックスとを用いた複合体で 最も一般的な樹脂を結着材として用いセラミック スもしくは金属粒子を充填材として用いた複合体 の場合では、複合体としての特性は改善されるが、

子間の距離が大きく、複合体の種々の特性の改善の為には、複合体中に占める連続相の量を減少し、この様な課題を解決しようとしている。 しかし従来の技術だけを用いた複合体では、 連続相の量はたかだか 1 / 2 程度にしか減少できなかった。

本発明は、かかる従来の課題に対してなされた もので、加工性、機械的強度、耐久性及び耐環境 性に優れた新規な複合材料とその製造方法とを提 供することを目的とする。

異題を解決するための手段

本発明は、無機質で粒子状の第1の物質と、この第1の物質とは構成元素もしくは構成の内の何れの数、種類あるいは価数又は結晶構造の内の何れかが異なる第1の物質以外の無機質の物質とのの質とは別の相でから構成とれた微質が第1の物質とは別の相でかつ連続相を形成し、微小粒径質合体の気孔率が5%以下には合材料とその製造方法によって、従来の課題を解決した。

作用

本発明の複合材料は、 気孔率が低いため過密な 複合体を形成し、 素材が無機質が主体であること から耐熱性は非常に高い。

気孔が少ないため、上述の三角点の量が大幅に 減少する。

又、気孔率を5%以下にする事により、複合体の気孔が全て関気孔(即ち複合材料内部の気孔全でが、複合材料の表面と直結していない)となり、

また本発明の複合材料に供される構成材料は、 第1の物質1も第1の物質以外の物質2も共に無 機質であるが、この複合材料の用途分野によって 具体的構成材料は変わる。

但し本発明で書う第1の物質以外の物質とは、 第1の物質の構成元素もしくは構成イオンの何れ かの数、種類あるいは価数又は結晶構造の内何れ かが異なっていればよい。 これらの何れかが異な ることによって、第1の物質とは物性が異なるも のであればよい。 具体的には第1の物質が金属で ある場合には、金属酸化物や金属窒化物が構成元 素、構成元素数、構成元素の価数かつ結晶構造等 が異なる例である。また構成材料が金属とセラミ ックスである場合も、これらが異なる。

例えば発明の複合材料を例えば磁気ヘッド、 紐 芯もしくは永久毎石等の毎性材料に適応する場合の構成材料としては、 例えばコパルト、 ニッケルもしくは鉄等の毎性金属やこれら金属を含有する合金を含むことが必要である。

また複合材料を紐性材料に適応し、第1の物質

機械的強度、耐量填符性(耐食性)及び加工性等 が向上する。

また平均的に混合分散されている従来の複合体の場合では、 構成材料の特性が得られるが、 本発明の複合材料は、 第1の物質以外の物質の構成材料混合比を第1の物質に比べて極端に少なくすることにより、 複合材料自体に例えば333.9% 全域でありながら同時に電気的絶縁体である複合材料や、絶縁特性を示しながら良熱伝導体であると言ったとうな新たな機能を付加できる。

#### 寒腔例

第1図に本発明の複合材料の基本的形態の新面 概念図を示す。 粒子状の第1の物質1が、 第1の 物質1とは別の相でしかも連続相を形成した第1 の物質以外の物質2で覆われた形状を有する。

本発明の複合材料は、複合材料の気孔率を5%以下にしたものであるため、粒子状の第1の物質1が3個以上集まる領域の三角点3の複合材料全体に占める割合も、三角点3自体の気孔率も極めて少ない。

1 が磁性金属材料で形成されている場合では、 第1 の物質以外の物質 2 に軟磁性材料特に、 フェライト、 Mn - Zn フェライトや Ni - Zn フェライト等のフェライト系を用いた複合材料とすることにより、 高い透磁率を得ることが出来る。

また本発明の複合材料を熱伝導性材料として用いる場合には、例えば銀、アルミニウムもしくは 銅のような熱伝導性の高い金属や合金が必要である。

更に本発明の本発明の複合材料を構造材料として用いる場合の構成材料には、剛性の高いセラミックス、金属もしくは合金等が一般的であるが、逆に例えばカーボン、グラファイト、NoSa、BN等の固体超滑剤のような創性の低い材質も応用分野によっては用いられる。

本発明の複合材料は、上述のように広い応用分野に選応できるが、特に電気抵抗と他の特性値と で新たな効果を発揮する分野の応用が好ましい。

従って第1の物質1もしくは第1の物質以外の 物質2の何れかに、誘環特性か絶縁特性を有する 材料を用いると良い。

このような材料としては、例えばAliz Os, SiOz, TiO等の金属酸化物、例えばAlik, Fezik, Min Ma, B N等の金属窒化物等の金属化合物やセラミックス等が挙げられる。

本発明の複合材料は、基本構成として粒子状の第1の物質1をほぼ取り囲む第1の物質1の物質2があれば良く、第1の物質1もしくは第1の物質2がの物質2が2種類である必要はない。特に第1の物質2外の物質2が2種類なりを選集との場合には、例えば41202のような塑性が劣る物質とを組み合わせることに対する物質とを組み合わせることに対する物質とを組み合わせることに対するが質とを組み合わせることに対するが質とを組み合わせることに対するが質とを組み合わせることに対するが質がある。とは物質の機能により好ましいでなり、の物質の機能により好ましいでなく、例えてもの物質の機能により好ましいでなく、例えてものであるとはのとせっき、クスとの混合体であっても良いことは勿論である。

くなる。例えば上述した磁性材料の場合では、5mm未満の厚みになると、第1の物質以外の物質2の電気絶縁性が損なわれ、通常の磁性材料とほぼ特性が変わらなくなる。また連続相の厚みが厚いと、第1の物質1の特性が損なわれる傾向がある。例えば上述した磁性材料の場合では、50mmを越えると第1の物質1の磁性が損なわれ磁気特性が弱まる。

また第1の物質1の粒子の粒径は、通常0.1~1 00μ■程度の大きさであれば、ナノコンポジット材料に適応できる。

なお本発明の複合材料は、 第1図に示したような構成だけでなく例えば第2図もしくは第3図に示したような構成であってもよい。

即ち第2図は本発明の複合材料の構成材料を、2段階に分けて作成した複合材料である。 つまり第1の物質11と第1の物質以外の物質12とから構成された所謂本発明の複合材料の一方の面上に、 第1の物質11だけを更に積層した構成である。例えば第1の物質11に酸化アルミニウムの

本発明の複合材料は、第1の物質1の粒径と第 1の物質以外の物質2が形成する連続相の厚みと を類整することによって、新たな機能を複合材料 に付与することができる。特に第1の物質以外の 物質2が形成する連続相の厚みが、重要となる場合が多い。

第1の物質以外の物質2の連続相の厚みがナノメーターオーダーの場合には、特にこのような複合材料はナノコンポジット材料と呼ばれ、その特異な物性に注目されている。 本発明の複合材料もこのナノコンポジット材料も当然含まれる。

例えば本発明の複合材料を磁性材料として用いる場合には、この第1の物質1に磁性粉を用い第 1の物質以外に物質2に誘電性もしくは絶縁性材料を適応して形成された連続相の厚みを5~50mmにすると、高周波数特性に優れた磁気ペッド等に応用できるため好ましい。

このように連続相の厚みが薄いほど本発明の復合材料に特異な特性が発現させるが、薄すぎる場合には第1の物質以外の物質2の特性が出現しな

ような研磨材を用い、第1の物質以外の物質12に金属アルミニウムもしくは金属網のようなれたされたせ金属を適応すると、第1の物質で形成された可能し、又第1の物質以外の物質で形成される面100は、第1の物質以外の物質12が作る連続相及び三角点13の気気のの数質12が作る連続相及び三角点13の気気の物質・か、第1の物質と第1の物質以外の物質で形成される面100側の数度は高い。このことを利用し例えば研磨センサとして応用できる。

と言った特性も示す。

これら複合材料の製造方法の工程としては、 粒子状の第1の物質の周りを第1の物質以外の物質でほぼ覆う被覆工程と、第1の物質と第1の物質以外の物質とを気孔率5%以下の成形体を作成する成形工程との2つに主に大別される。

この被覆工程は、第1の物質の周りを第1の物質以外の物質でほぼ覆う工程であることから、本発明の複合材料の連続相の構成と厚みとをほぼ決定する重要な工程である。

形成させればよい。 あるいは第1の物質以外の物質に塑性変形量が異なる複数種の物質を用いることに依っても、 塑性変形量の大きい物質が小さい物質の切れ目に入り込み、 第1の物質を覆わせればよい。 この塑性変形量の大きい物質としては、例えば前述した超塑性材料がある。

更にこの成形工程中において、一軸プレスすることにより第1の物質の形状を偏平化すると、 特性に異方性を有する複合材料ができ、この異方性を積極的に応用でき好ましい。

なおこの成形工程時に、第1の物質以外の物質に焼結助剤を添加すると、複合材料の焼結をより促進する役目を果たし、B203等のより業系化合物、Pb0等の鉛系化合物、Y205等のパナジウム系化合物もしくはB1203等のピスマス系化合物等が挙げられ、必要に応じて適宜添加される。

更に本発明の複合材料の成形体を高温高圧下で 熱処理を行い、気孔率を3%以下にする高密度化 工程を加えると、複合材料の機械的強度。磁気特性、熱伝導性、耐久性、耐環境性もしくは加工性 大に成形工程の手法としては、高温高圧である。 しなできる。 とができる。 とができる。 かしこの成形工程は、 複合材料の気孔 要を 5 %以下にし、 本発明の複合材料の構成。 機械率を 5 %以下に耐暖境等を 5 の気 元 で 処理 しる で が 気 度 と られ、 画 席 第 1 の 物質 以外の の お 水 と られ、 画 席 第 1 の 物質 以外の が か 水 と の を 手 法が と られ、 画 常 第 1 の 物質 以外の が 水 に よ り 等 方 的 な 加 圧 あ る い は 一 軸 方 向 に プレス 加 圧 し て 得 られる。 具体 的 に は 500 ℃ 以上 に 加 無 し て 得 られる。 具体 的 に は 500 ℃ 以上 に 加 無 し て 得 られる。 更 力 印 加 で 達成 される。

但し第1の物質に比べ第1の物質以外の物質の 塑性変形量が小さい場合には、この成形工程時の 熱処理に第1の物質以外の物質同社が結合する とにより、複合材料的の特性を損なってしまう。 このような欠点を解消するため、第1の物質が発力の物質の化合物である場合には、第1の物質の化合物で成形工程 を行うことにより、第1の物質以外の物質を追加

等の複合体の特性が更に良好となり、場合によってはこれら特性に異万性が現れるため好ましい。 この高密度化工程と成形工程との違いは気孔率の値であり、要は高温高圧下で処理することには変わりはない。 但し気孔率の値が異なると言うことは、高密度化工程の方が一般により高圧下で行う。

なお前述した偏平化をこの高密度化工程で行ってもよい。

以下、実施例をあげて説明する。

# 実施例 1

第1の物質として平均粒径30μ mのFe-Al(Al含有量5%)合金の粉体を、800℃にて1時間空気中で加熱酸化することによって、第1の物質以外の物質として酸化アルミニウムの薄膜を、粉体表面に均一に形成した。酸化アルミニウムは誘電体であり、上記被覆粉体は完全な絶縁体であった。

この被覆粉体に、結着剤として低温揮発性ワックスを0.05重量%混ぜて成形し、この結着剤を加熱し除去した後、空気中にて圧力50kg/cm²、1350℃の条件で1時間点成した。得られた焼結体は約

4.2%の気孔準を有しており、 充分遺迹であった。

この試料を切断して研磨したところ、表面は観面となり、第1の物質であるFe-Al合金の特徴を反映した金属光沢を有していた。

また複合材料中の三角点が占める面積率は、約3%であり、またその大きさは約1.2~2μョで第1の物質の粒径の約1/15以下であった。このように三角点の割合が小さいのは、第1の物質が圧縮され塑性変形したためである。

一方研磨面の電気抵抗を測定したところ、 約15 MΩであった。 第1の物質として用いた Fe-AI合金のみではせいぜい数Ω程度であり、 導電性を示す。これに対して本発明の複合材料は、 一見第1の物質そのものに見えるが、 電気抵抗はきわめて高いという相反した特性を有する。

また本発明の複合材料の硬度を測定したところ、 第1の物質の約30%増であり、 大幅な改善が認め られた。

従って本発明の複合材料は、Fe-Al合金と同じ外観でありながら、抵抗値及び硬度が高く、高耐熱

ある。

実施例2

次に平均粒径15μmの純鉄粉体を第1の物質として用い、この純鉄粉体にアルミニウムをスパックーして約0.05μm(約50mm)の薄いコーティング層を先ず形成した。

このアルミニウム薄膜を有した純鉄粉体を、実施例1で述べた活性なガスを用いるプロセスによって得た複合材料は、やはり上記と同じ高い抵抗を示すなど所望の特性を得た。

実施例3

Fe-AI-SIよりなる平均粒径 3 μ a の 合金粉体を第 1 の物質とし、これに 0.1%のポリビニールアルコール液を加え、5000kg/cm²の高圧で成形した。 この成形体を 1 時間空気中800℃で加熱して、 第1の物質以外の物質として主に酸化アルミニウムよりなる薄い酸化膜を形成させた後、 ホットプレス 装置にいれ、 空気中で800℃に加熱し200kg/cm²の圧力で 3 時間加圧焼成した。

得られた複合材料は、5%以下の気孔率を有し

性という特性があった。

上記の複合材料を耐熱性の容器に充填し、酸素を常圧で封入して、800℃に加熱し2000kg/cm²の圧力を2時間かけたところ、気孔率は更に低下し0.1%以下の高密度焼精複合材料を得た。

高密度焼結複合材料の電気抵抗値は20MΩ以上でありテスターでは測定限界を越えていた。また硬度は約125%に改善され、三角点の面積率は0.1%以下であった。

なおこの高密度化工程を窒素中及び空気中でも 行ったが、第1の物質が窒化又は酸窒化されたこ と以外は何れの場合にも同様の特性を示した。

一方複合材料をアルゴン雰囲気中で再び耐熱性の容器に封入し、上述した高密度化工程と同じ条件でポットプレスしたところ、気孔率は1.5%以下の高密度焼結複合材料を得た。ところが電気抵抗値は1分以下であり、粒界の誘電体膜が破壊されていることが電子顕微鏡で観察された。

このように本発明の高密度化工程は、 酸素もしくは窒素等の活性ガスを含む雰囲気で行う必要が

ていたが、 金属光沢の鏡面に研磨され、 抵抗値は 20NΩ以上を示した。

なおホットプレス時の重量増加は、別のモデル 実験の結果より0.1%であり、従って99.9%金属で あることが示されているが、高抵抗値を示した。

即ち、焼結の過程に於いても第1の物質以外の物質相の形成が為されることが判明した。この場合には、第1の物質の構成要素のアルミニウムが、空気という活性がスによって、電気絶縁性の高い誘電体製である数窒化アルミニウムを形成し、これが第1の物質以外の物質の機能をしている。

また本実施例の複合材料のビッカース硬度は、 従来材の500~550に対して700以上の非常に高い値 を示した。

更に三角点に相応する面積率は、2.5%以下と非常に小さいものであり、その平均粒径は第1の物質の平均粒径の1/20と小さなものであった。

なおホットプレス圧力を400kg/cm²に増圧した 結果、3%以下の気孔率を得、抵抗値20MΩ以上、 ビッカース硬度720を得た。800kg/cm²の圧力では さらに高い750以上の硬度を得た。

#### 宴览例 4

平均粒径15μmのアルミニウム金属粉体を第1の 物質とし、これを300℃に加熱し5%の酸素雰囲気 中で2時間酸化処理を行い第1の物質以外の物質 の皮膜を形成した。

この被覆工程の後、500℃に加熱し500kg/cm²の 圧力下0.5%酸素雰囲気中でホットプレス焼結を行 なった。

得られた複合材料は、アルミの約2倍の硬度を 持ち、抵抗値は20NΩ以上を示した。

尚、本実施例の複合材料の場合には窒素中にて ホットプレスした所、抵抗は約15MΩであった。

また硬度が高い為に加工抵抗性が増しているが、 従来のアルミの様に加工される。

なお、この複合材料の成形工程時のホットプレスを一軸性にすることにより、 球状に近い第1の物質の形状が2: 1以上の偏平状に変形した。

圧力と一軸性を調整することに依って、 さらに 偏平度を変化させることもでき、10: 1程度まで

# の酸化膜を種々の厚みで形成させた。

膜の厚さと組成は、熱処理時の重量増加、オージェ分光分析及びArスパッターによるデプスプロファイルにより評価した。

これらの粉末を成形し、金属アルミニウムパイプ中に真空封入し、加熱温度 600℃、1000kg/cm²の圧力で 2 時間、Arガスによる等方加圧を行い、複合材料を作製した。

得られた複合材料より、 2 × 1 × 12mmの柱状試料を切り出し、その密度、電気抵抗(テスターによる)、熱伝導率を測定した。 結果を第1 表に示した。

比較のため、金属AIおよびAI:0:焼結体についても同様の測定を行った。

(以下余白)

#### 実現できる。

この様な材料は、硬度異方性や耐寒延異方性を 有しており、有用な応用が考えられる。

#### 実施例5

アルミニウム粉体を乗1の物質とし、この第1の物質と第1の物質以外の物質としてのTiS微粉とをポールミルによって80時間混合し、乗1の物質の表面保飾を行なった。

表面修飾された第1の物質を550℃に加熱して窒素中にて窒化処理し、表面のTiBを窒化物に変性した後に、400℃に加熱し500kg/cm²の圧力印加を行なって、ホットプレス焼成で成形した。

この結果、アルミ材に比較して硬度が約1.5倍、 抵抗値が20NΩの複合材料が得られた。

熱伝導性はアルミニウムにほぼ近い良好な結果 を示した。

#### 実施例6

平均粒径約20μmのアルミニウム金属粉末を第1の物質として用い、これを第1表に示す各種温度で加熱処理し、その表面に第1の物質以外の物質

第 1 表

熱処理	展 厚	歪度	抵抗	熱伝導率
℃-hr.	D a	(g/cm²)	Ω	W/a·deg
<del>-</del>	2	2.63	< 0 . 1	190
400-lair	5	2.67	180	190
450- lair	18	2.62	3 2 K	189
500-lair	3 5	2.59	780K	0 3 1
600- lair	47	2.57	> 2 0 M	150
600-50air	6 8	2.53	> 2 0 M	110
620-50air	130	2.45	> 2 0 M	8 0
A 1		2.70	< 0 . 1	200
.0,	-	3.91	> 2 0 M	2 0

例えば電子部品用絶縁基板としては、 磁気抵抗は高い方が良いが、 熱伝導率が金属の1/2以下では

従来材料に対して優位性は少ない。 更に密度が低い場合には(すなわち95%未満の密度であると)、多くの開気孔が存在すると考えられ、 強度低下等、実用上では課題が多い。 従って電気抵抗は若干低くても金属並の熱伝導率があれば、 磁気ヘッド用スライダー材をの他の用途もある。

絶縁体である金属酸化膜の抵抗値は101.2 Ω cm以上と高いが、5~20mm程度の膜厚を有する被覆粒子から得られた複合材料の全体の抵抗は、上記金属酸化膜の抵抗値から予想される値より小さい。 立動化膜は明らかに粒界に存在しているので、絶縁体は金属磁性体粒子の表面をほぼ覆うように存在している。 しかし部分的に絶縁体にピンホールがあり、金属粒子同士がごく狭い面積で部分に抵抗値がや低いと考えられる。

そこで、被覆粉末を酸素ガスとともにAIハイブに封入し、前述と同様にホットプレスを行ったところ、鎮厚が5~50mmの試料でも、その電気抵抗

これらの複合材料の焼結密度および、電気抵抗を以下の手法で測定した。

各原結体の断面を研磨し、光学顕微鏡にて観察及び焼結体の密度を測定した結果、気孔率で 1%以下の緻密な材料であった。また各焼結体から 3×5×10mm<sup>3</sup>の棒状試料を切り出し、その両端に!m-Gaの電極を形成し、これらの試料の電気抵抗を測定したところ、電気抵抗は10<sup>1</sup>~10<sup>2</sup>Ωcaを示した。

#### 実施例8

第1の物質として実施例7のSI-AI-Fe合金の球状粉末に、第1の物質以外の物質として超塑性絶縁材料のY₂O₂を3aol%含む正方晶ジルコニア多結晶体(以下Y-TZPと記す)をSI-AI-Fe合金粉体の重量に対して1 vt% 添加し、トルエンを溶膜としてボールミルにて均一に混合した。

このスラリーを窒素ガス気流中にて混合乾燥させ、これに昇華性の有機パインダーである稼ಟを 5 vt % 添加し、乳鉢にて更に混合した。

この混合粉を1000kg/co²の静水圧下で等方的に

が1.5~10\*倍大きくなった。但し、密度は変化しなかった。このように高密度に成形する時に更に第1の物質以外の物質(この場合は11:0;)が追加形成する効果が認められる。

#### 実施例7

第1の物質としてSiが10vt%、Alが6vt%、Feが84vt%の組成のSi-Al-Fe合金の球状粉末(#250メッシュ語以下、平均粒子径約30μm)に、第1の物質以外の物質として超塑性を示すBl20x、K20、U02を各々別々にSi-Al-Fe合金粉体の重量に対して1vt%添加混合し、各々別々にトルエンを溶誤としてボールミルにて均一に混合した。

このスラリーを窒素ガス気流中にて混合乾燥させ、これに昇華性の有機パインダーである権脳を5 wt% 添加し、乳鉢にて更に混合した。

この混合粉を1000kg/cm²の静水圧下で等方的に 加圧成形(直径30mm厚さ30mm)し、この成形体を 800℃の温度の不活性雰囲気中でホットプレスし、 複合材料を作製した。プレス圧力は1000~2000kg /cm²で、プレス時間は2時間加圧した。

加圧成形(直径30mm厚さ30mmの円盤形状)し、この成形体を800℃の損度の不活性雰囲気中でホットブレスし、複合材料を得た。プレス圧力は1000~2000kg/cm²で、プレス時間は2時間加圧した。

その焼結体の焼結密度および、電気抵抗を実施例でと同様な手法で測定した。

その結果焼結密度は気孔率で1%以下の過密な 材料で、電気抵抗は101°Ωcmであった。

# 実施例9

この複合材料の焼結密度および、 電気抵抗を実施例7と同様な手法で測定した。

その結果焼結密度は気孔率で 1 %以下の関密な 材料で、電気抵抗はやはり10'\*Ωcmであった。

このように実施例7では電気抵抗は10'~10°Ω cmであったが、実施例8及び9では電気抵抗が10'\*Ωcmであったのは、第1の物質以外の物質とし て用いたT-TZPもしくはアパタイトが各々低温から 超塑性を示すため、SI-AI-Fe粉末粒子の塑性変形 に応じて充分に塑性変形するためである。

この様に超塑性を示すY-TZPやアパタイトを絶縁 材料として使用した場合には、気孔率が5%以下 の高密度で、高電気抵抗の複合材料が得られる効 果が顕著である。

#### 比级例1

実施例7のSI-AI-Fe合金粉体を使用し、超塑性 絶縁材料のY-TZPを添加しないで、これに種脳を5 \*1%添加し、実施例7と同様に成形体を作製し、 同一の条件でホットプレスした。

その焼結体の焼結密度および、電気抵抗を実施 例7と同様な手法で測定した。

その結果焼結密度は気孔率で1%以下の稠密な 材料であったが、電気抵抗は10-4Ωcm程度と金属 材料と同程度の低抵抗であった。

#### 比较例2

実施例7のSI-AI-Fe合金に対して、高電気抵抗 材料のAI:0:粉末を重量比で1%の割合(体積比で

いぜいであり、それ以上の抵抗は得られなく、まして実施例 8 もしくは 9 の Y-TZPもしくはア パタイトを添加複合化したときのように、 10°Ω c ■以上の電気抵抗を有するものは得られなかった。

本発明によれば、上述した実施例7~9のように全属材料を多く含有するが、電気抵抗の高い複合材料が得られる。

このように金属材料の電気抵抗を高く出来ると、 従来の金属材料では出来なかった特性を引き出せる。例えば一般に金属磁性体は、高飽和医素で度であるが、その電気抵抗が10~4 Ω cm程度と低いため、渦電流損失のため、高周波領域では使用出来なかったが、本発明のように1 \*1 \*2 程度の超速ででの絶縁材料と複合化することにより、飽和超速での絶縁材料と複合化することにより、飽和超速でで、電気抵抗を10°Ω cm以上に大きく出来るので、従来使用出来なかった高周波領域・例えば1 MBz以上)で使用出来る笹芯材料が得られる。

実施例7~9では、Fe-Si-Al合金に超塑性の絶 縁材料を添加複合体化した例を示したが、Fe-Si1 \*1%)で添加し、更に実施例7と同様にY-TZPを 追加し、実施例7と同一な方法で複合焼結体を作 製し、その焼結密度、電気抵抗を制定した。

その結果、複合体の気孔率は1%以下と高密度であったが、その電気抵抗はやはり10・4Ωcm程度と金属材料と同程度の低抵抗であった。

その他Y-TZP以外にもSIO.又はCaO等の高電気抵抗材料(絶縁材料)について、Y-TZPと同様にSI-AI-Fe合金に添加して複合焼結体を作製し、その気孔率(焼結密度)、電気抵抗を測定したが、気孔率が5%以上の比較的低密度のものでは、その電気抵抗が高い(>10°Ωca)試料が作製できたが、気孔率が5%以下の高密度複合体では、高密度になるほど、絶縁層が破れ易くなるため、電気抵抗が低下し、ほぼ金属なみの10°4Ωca程度の抵抗のものからせいぜい10°Ωca程度のものまで作製できたが、抵抗値のばらつきがあり、高抵抗の複合材料が再現性よく得られなかった。

すなわち実施例7の各超塑性の絶縁材料をただ 単に添加複合しただけでは、 10'Ω c = の抵抗値がせ

AI合金に限らず、他の金属例えば、Fe-Co系合金や、Fe-SI系合金、Fe-NI系、Fe-AI系合金等、あらゆる金属及び金属系化合物にたいしても、超塑性の絶縁材料を添加複合し、高密度に焼結若しくは固体化したときに、電気抵抗を絶縁体程度にまで高くすることが出来る。又、超塑性を示す物質の添加量も1\*t%に限定されるものではない。

更に実施例7~9では、成形体を作成するための結着材として種脳を用いたが、結着材はこれに限定されるものではなく、例えばポリメタクリル酸メチル等のような高温高圧下で昇華する結着材であれば適応できるし、又、容器に封入すれば結着材を必ずしも必要としないといえる。

#### 実施例10

Sin 10vt%、Aiか 6 vt%、Feが 8 4vt%の組成の Si-Ai-Fe合金の球状粉末(#250メッシュ、 平均粒径約30μa)を、NiCia、ZaCia及びFeCiaを含む70 での水溶液に浸し、pHを7~8に調整して反応させた。このようにして溶液中では粉末の粒子表面に金属イオンを吸着させ、次に空気中で酸化させ

てフェライト化反応を起こさせる。

この二つの工程を交互に繰り返して行い、厚さ 5 mm~50mmの数磁性のNI-Zmフェライト薄膜を形成させた。

なおこれとは別に、厚さ5 nm  $\sim 50 n$ m o N1-2n7  $_{x}$   $_{y}$   $_{z}$   $_{z}$ 

上記飲磁性のフェライトにより被覆したSi-Al-Fe合金粉体を500kg/cm²で加圧して、成形体を作製後、1000℃に加熱し300kg/cm²(N₂中)の圧力で2時間ホットプレスし、複合材料を作製した。

この複合材料は、 磁性材料でありその磁気特性 及び電気特性を第4図及び第5図に示す。

第4図は、N1-Znフェライト薄膜の膜厚と得られた複合材料の透磁率μ (周波数100K Hz)の関係を示す。 第5図は、N1-Znフェライト薄膜の複合材料中の体積割合と複合材料の電気抵抗率を示す。

これらの結果を見ると、透磁率は、膜厚(50m

トプレスをして、複合材料を作製した。

この複合材料は  $\rho=10^{\circ}\sim10^{\circ}\Omega$  cmの高電気抵抗を示した。 しかし、 周波数 100Bz での透磁率  $\mu$  は 300の値を示し、 透磁率が低下している。  $S10_{\circ}$  の 膜厚を 5 nmに した場合では、 得られる複合材料の抵抗値は、  $\rho=10^{\circ}\sim10^{\circ}\Omega$  cmであり、 その透磁率は  $\mu=2500$  であった。

このことは、複合材料内部を通る磁束が、非磁性の絶線体のS102薄膜によりその流れが遮断されるため、膜厚が大きければ急激にその複合体の透磁率が低下していることを示している。

比较例 4

実施例 1 0 と同じ Si-Ai-Fe合金の球状粉末を、NiCl<sub>2</sub>と FeCl<sub>2</sub>とを含む 70 C の温度の水溶液に浸し、pHを 7 ~ 8 にして反応させた。 溶液中では粉末に金属イオンを吸着させ、厚さ 50 maの Fe-Ni薄膜パーマロイを形成した。

このFe-Ni薄膜により被覆したSi-Ai-Fe合金粉体を500kg/cm²で加圧して、成形体を作製後、Na雰囲気中で1000でに加熱し300kg/cm²の圧力で2時

~ 50mm)に殆ど存在せず、 μ = 5000~6000の値を示し、 電気抵抗率においては、 ρ = 10 ° ~ 10 ° Ω cm の値を示した。 この複合材料の飽和過度密度は、 9600Cであり、 出発原料別の金属値性体の飽和過度密度の値とほぼ同一であった。

同様の結果は、 Kn-Znフェライト薄質で粉件を置った場合でも、 確認された。

なお、Bn-Znフェライト薄膜の磁気特性及び、電気特性をガラス基板上に形成した薄膜により評価すると、飽和磁束密度<math>Bs=5000G、透磁率 $\mu=100$ 0、電気抵抗率 $\rho=1\sim10^3\,\Omega$  caであった。

比较例3

実施例 1 0 の SI-AI-Fe合金の球状粉末を、エトキシシランの水溶液に浸し撹拌した。次に、この溶液を吸引 5 過した後、 80 ℃で乾燥させると、厚さ50mmの非磁性の SIO, 薄膜が粉末の表面に形成した。

このS102により被覆したS1-A1-Fe合金粉体を、 500kg/cm²で加圧して、成形体を作製後、1000℃ に加熱し300kg/cm²(N2中)の圧力で2時間ホッ

間よットプレスし、高密度複合材料を作製した。

これとは別に厚さ50mmの Fe-N1薄膜それ自体の磁気特性及び電気特性を、ガラス基板上に形成したFe-N1薄膜より評価したところ、飽和磁束密度 Bs=8700G、透磁率  $\mu=20000$ 、電気抵抗  $\rho=60$   $\mu$  C.c. であった。

上記複合材料の電気抵抗率は $100 \, \mu \, \Omega \, cm$ であった。また、この複合材料の磁気特性は、 低周波である $100 \, \mathrm{Hz}$ においては  $\mu = 5500$ 、 高周波数  $1 \, \mathrm{MHz}$ においては、 $\mu = 30$ の値を示した。

このことは、複合材料の電気抵抗が小さいため、 「高周波領域では、渦電流の発生にともない透磁率」 が急激に落ちることを示している。

比切明5

実施例10と同様のSI-AI-Fe合金の球状粉末を、NICI,とFeCI,とを含む70℃の水溶液に浸し、pHを7~8で反応させた。溶液中では粉末表面に金属イオンが吸養した。次に空気中で放化させてフェライト化反応をおこさせた。

この二つの工程を交互に良り返して行い、 厚さ

特閒平4-21739 (11)

|100mm~|1000mmのNiFerO.フェライト薄膜を形成させた。

なおこれとは別に、厚さ100mm~1000mmのNiFe<sub>2</sub> 0.7 ェライト薄膜自体の磁気特性及び電気特性を、ガラス基板上に形成した薄膜により評価した。 その結果、飽和磁束密度Bs=3400C、透紅率 $\mu=10$ 、電気抵抗 $\rho=10^3\sim10^4\Omega$  cmであった。

上記フェライトにより被覆したSi-Ai-Fe合金粉体を500kg/cm²で加圧して、成形体を作製後、Na雰囲気中1000でに加熱し300kg/cm²の圧力で2時間ホットプレスし、複合材料を作製した。

この複合材料の磁気特性は、周波数  $1\,Maz$ で、 $\mu$  = 120の値を示し、電気抵抗は、 $\rho=10^\circ \sim 10^\circ \Omega$  c sの値を示した。

このことから、透短率の低い、厚さ100mm以上の 絶縁原で磁性粉末粒子表面を覆うと、複合材料と しての透磁率は、著しく低下することが判る。

実施例10及び比較例3~5に示したように、 第1の物質以外の物質として、 高電気抵抗でかつ 軟磁性の材料を選択し、 この軟磁性材料で金属磁

aの絶縁膜を形成し、 第1の物質以外の物質とした。

この被理粒子粉体を500kg/cm²で加圧成形して、 成形体を作製後、Ar雰囲気中800℃に加熱し1000k g/cm²の圧力で2時間ホットプレスし、高密度( 相対密度38~99%)複合材料を作製した。

この複合材料の周波数と実効透磁率の磁気特性を、第6図に示す。

上記複合材料の電気抵抗率は、  $10^7 \sim 10^9$  ( $\Omega$  cm) と高抵抗であるため、透磁率は周波数に殆ど依存せず、  $10kBz \sim 1MBz$ の範囲に於て  $\mu=1300 \sim 1400$ の値を示し、 膜厚の増加にともない減少することが示している。

なお、焼詰助材の悉加物として8:0,を被理粒子 粉末に対して0.05~0.10重量の割合で加えて加圧 成形して、同様のホットプレス条件で焼結を行った。 高密度焼結(相対密度99.5%)が建成され、 より薄い絶縁度(7m)でも高電気抵抗が得られた。 さらにこの複合材料は、高周波数領域でもμ =1700~1800の値を示した。

奥施例12

性材料粒子の表面を被覆すると、得られる複合材料は高電気抵抗を有し、かつ飽和磁束密度及び透磁率が高いことがわかる。

実施例10及び比較例3~5では、SI-AI-Fe 系 金属磁性体について述べたが、本発明はこの材料 及び組成に限定するものではなく、他の磁性金属 についても同様の効果があるものである。

また第1の物質以外の物質として、 高電気抵抗の 研性材料を選択すれば、 高飽和磁東密度で高透 研写の複合材料を得ることが出来るが、 実施例 1 0 に示したように、 その中でもより高電気抵抗で、 高透磁率のフェライト、 中でも、 Ma-Zaフェライトや N1-Zaフェライトを使用した場合に高周波領域で高透磁率のナノコンポジット材料が得られる。

#### 実施例11

第 1 の物質として組成が重量比でNI: Fe = 78.5 : 21.5のNI-Fe合金の球状粒子粉末(#250メッシュ、平均粒径約30μa)を準備した。 この粉末粒子表面に 窒素雰囲気下、 A1をターゲットとしてスパッタリングを5 分間行い、 A1Nを主成分とする厚さ数π

重量比で組成がNI: AI: Fe = 10:6:84のNI-AI-Fe合金の球状粒子粉末(#250メッシュ、 平均粒径約30μa)を第1の物質として準備した。 これを流量200cc/aiaの窒素雰囲気下で800℃に加熱し1時間熱処理を行ない、 AINを主成分とする厚さ30aaの絶縁膜を第1の物質以外の物質として形成した。

この被覆合金粉体を500kg/cm²で加圧成形して、 成形体を作製後、Ar雰囲気中で300℃に加熱し100 0kg/cm²の圧力で2時間ホットプレスし、相対密 度98~99%の高密度複合材料を作製した。

この複合材料は、  $ho=10^{\circ}\sim10^{\circ}\Omega$  c o の高電気抵抗率を示し、 その磁気特性は、 周波数 1 MHz で透磁率  $\mu=1470$ 、 飽和磁束密度は 95000 の値を示した。

この実施例より、アルミニウムを成分として含む金属粒子を使うことにより、Naがス雰囲気中で熱処理するという量産に適した簡易な方法で、Al Nを主成分とする絶縁膜を均一に形成することができ、さらにこの接置膜は高温高圧時に破壊されない強度を持つことが確認された。

実施例!3

実施例12と同じのNI-AI-Fe合金の球状粉末を用い、実施例12と同様の手法でAINを主成分とする厚さ5~10mmの絶縁膜を球状粉末粒子の表面に形成した。

この合金粉体に、 添加物として B<sub>2</sub>O<sub>2</sub>を0.01vt% ~ 0.50vt% の割合で加え、 B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>として 2 n<sub>2</sub>~ 100a a の 無厚換算として 添加した。

又比較のためPb0,8i20a,V20a,Si0aをそれぞれ2~100mmの展界になるように添加した。

これらそれを500kg/cm²で加圧して成形体を作 製後、Ar雰囲気中で500℃に加熱し1000kg/cm²の 圧力で2時間ホットブレスし、相対密度99%の高 密度複合材料を作製した。

この $B_2O_3$ ,  $PbO_3B1_2O_3$ ,  $V_2O_6$ を添加した A1Xとの合計 膜厚  $5\sim50\,n$ mのナノコンポジット 磁性材料は、  $\rho=10^\circ\sim10^\circ$   $\Omega_3$ cmの高電気抵抗率を示し、第6図に示すようにその磁気特性は、周波数  $1\,N$ H2で透磁率  $\mu=2000$ 、 数和磁束密度は  $9500\,G$ の値を示した。 また  $B_2O_3$ の代わりに  $PbO_3$   $B1_2O_3$ ,  $V_2O_6$ を用いた場合も、 同様の結果が得られた。

### 実施例14

本実施例では構造材料の一例に付いて述べる。
平均粒径20μmのAI粉を第1の物質として用い、
流量200cc/minの大気中で600℃に加熱し10時間で
粉体表面のみを極薄く酸化処理し、A1201を主成分
とする厚さ数10mmの絶縁膜を形成し、第1の物質
以外の物質とした。これを500kg/cm²の圧力で加
圧成形を行ない、円盤状の試料を作製した。この
成形体に対して、大気中で600℃に加熱し30分保持
した後、500kg/cm²の圧力でホットプレスを行な
い、その圧力で30分保持した後、圧力除荷、徐冷
して、直径13mmで厚さ9.6mmの円盤状の複合材料を
得た。

このようにして得た複合材料の電気抵抗率は、 $6 \times 10^{\circ}$   $\Omega$  caであった。 機械的特性は、 A1 同様の延性が確認され、 熱伝導率も  $200 \, \text{M/a-k}$ であり、 従来の $A1-A1_20$ ,系の複合材料よりも高い値を示した。

#### 実施例15

本実施例では、磁芯として使用される複合材料に付いて述べる。

しかし、他の添加物 N z Oでは、μ が 1000~1500で あった。 なお、 展厚が 50 a m を越えるとμは 1000以 下となった。

実施例12と比較すると、Pb0.81201.Y201.8201の 添加により、より薄い絶縁膜でも高電気抵抗率を 実現したため、磁気抵抗によるμの低下を最小限 に抑えることができ、高周波数領域で高い透磁率 を得られることがわかる。

次に、S1-A1-Fe系合金粉体の表面に A120,の絶縁 膜を5 nm~30 nmの厚みに形成し、 更に B20,を10~ 20 nm皮膜が形成され得る量だけ添加した。 これを 前述のようにホットプレスし、 高密度複合材料を 作製した。 この複合材料は、 ρ=10°~10°Ω cmで μ=2500という高い磁気特性を示した。 しかしな がら他の B1202, V205, Pb0では、 同一膜厚でも μ= 2000であり、 B20,が特に優れていることがわかっ た。 他の磁性合金でも、 A1をその成分として含む Fe系合金においてのみ、 酸化アルミニウムー B205, 窒化アルミニウムー B205, 酸窒化アルミニウムー B205の組み合せで、 高透磁率が得られた。

ガスアトマイズ法により作製した、ほぼ球形粒子から成る平均粒径約20μmのセンダスト合金(Fe-Si-Ai合金)を、各種酸素濃度雰囲気中で850℃~950℃にて、1~10時間熱処理した。この時の重量変化を測定した。またこれら粉末の表面をオージェ分析したところ、いずれも主としてAi2O,が形成していることが分かった。

次にこの粉末を気密容器中に酸素置換して封入 した後、熱間静水圧プレス装置により800℃の加熱 下で2000kg/c=²の圧力で3時間焼結し複合材料を 得た。得られた複合材料の表面が鏡面となるよう に研磨して、約10ミリ間の表面抵抗をテスターで 測定した。又0.5ミリ厚みの試料を作製し、1 MHz に於ける透磁率も測定した。以上の結果を第2表

なお参考のために、 熱処理をしていない粉末の 焼結体での結果についても併せて示す。

(以下余白)

第 2 表

重量增(%)	抵抗(Ω)	透色率 I NB z 0 . 5 t
- (無処理)	~ 0	7 0
0.010	5	700
0.10	2 0	1500
0 . 5	5 0	1000
1.0	700K	800
1.8	> 2 0 N	700
2.5	> 2 0 M	1 0 0
3.0	> 2 0 N	8 0

第2 表より明らかなように熱処理による重量増加が大きいほど抵抗値が大きくなり、1.8%以上でバルクは金属でありながらほぼ絶縁体に近い抵抗値を示す。

又0.5ミリ厚みの 1 MBzでの透磁率は、無処理のものは渦電流損の為70と低い値となっているが、熱処理による重量増加が0.10~0.5%で透磁率はほぼ極大を示し、更に重量増加するとむしろ低下し3%では80と低い値となる。これは酸化層は非磁

するのは、等方向に塑性変形をおこさせるため、 絶縁層を破れにくくするのに有用である。

また活性ガスによる第1の物質の重量増加を0.01%以上2.5%以下としたのは、0.01%以下では絶縁が不十分であることが多く、また2.5%以上では磁気特性が劣化する傾向が現れるためである。

得られた複合材料の気孔率は3%以下が好ましい。 気孔率が3%以下の複合材料は充分な機械的強度を有し、 磁気ヘッドへの応用を考えた場合テープ指動面にこれ以上気孔があると強度不足となり問題となるからである。

なお本実施例では、第1の物質としてFe-Si-Al 合金について述べたが、他の合金、例えばAl,Siを 含む合金についても同様の効果が考えられること 勿論である。

# 実施例16

重量比で組成がSI: AI: Fe = 10: 6: 84の平均 粒子径約30μοのSI-AI-Fe合金の球状粉末を第1の 物質とし、800℃にで5分間空気中で熱処理し、そ の表面に第1の物質以外に物質として酸化築を形 性層であり、 この非磁性層の厚みが厚いために磁 束が通りにくくなるためと、 酸化の影響で磁性層 自身の特性が損なわれるためである。

本実施例で得られる複合材料は、第1図に模式 断面図で示したように、第1の物質1の周辺が第 1の物質以外の物質2の絶縁相(Alion)で扱われ た形となっている。この絶縁相の厚みは実際には 数maないし数10mmである。

なお粒子状の第1の物質の大きさは、実際に磁 芯として使われる周波数帯即ち、 渦電流損失に応 じて適宜選択すればよい。

また、熱間静水圧プレス時に気密容器中に酸素を含んだ状態で封入するのは、 焼結するときの塑性変形時に絶縁層が破れても、 その部分に酸素を供給して金属磁性層の導通を抑制するためである。本実施例では、 酸素ガスにつてい述べたが、 第1の物質と反応して誘電性もしくは絶縁性の第1の物質と反応して誘電性もあっては2、 特に酸素に限定するものではない。

更に本実施例で使用した熱間静水圧により焼結

成した。 膜の厚さを、 熱処理時の重量増加、 メージェ分光分析及びArスパッターによるデブスプロファイルにより評価したところ、 約9 maであった。

この粉末を成形し、1000kg/cm²の圧力でArガス 雰囲気下、800℃で5分~2時間ホットプレスし、 複数個の一次試料を作製した。一次試料の密度を 測定したところ、真密度6.89g/cm³に対して、ホットプレス時間が5分のものは相対密度78%、20 分ものは90%、2時間のものは98%であった。それぞれの試料をNo1~3とした。これらの試料 (重量約3g)について、それぞれ次の3種類の処理を行い、処理後の試料を各々No4~6、7~ 9及び10~12とした。

試料N o 4 ~ 6: 試料N o 1 ~ 3 を各々空気中 にて700℃で約10分熱処理した後、 気密性容器に真 空封入した。

試料No7~9: 試料No1~3を各々気で性容器に設無約10ccとともに封じ込めた。

試料N o 1 0 ~ 1 2: チタンエトキシドの0.01 モルエタノール溶版100mlを3個準備し、この溶液 に試料No1~3を各々投入し、70℃で加熱遠流しながら、水/エタノール=1/3混合溶液を、水の量が0.002年ルとなるまで適下し、3時間加熱遠流した。終了後、生成物をろ過し、得られた粉末を150℃で乾燥させた後、空気中にて400℃で1時間熱処理した。得られたものを気密性容器に真空對入した。

上記1番目の処理法は、一次試料気孔部分の絶 疑摩を増加させる目的で行った。 2番目の処理 法はガスを一次試料の気孔部に充填することにより、後述する2度目の高圧成形時にこのガスとと 孔部分の金属とを反応させて絶縁膜厚を増加させる目的で行った。 3番目の処理法は、 T102の 皮膜を一次試料の空孔部分の表面に形成させる目的で行った。

これら合計 9 種類の試料を、Ar雰囲気中で、800℃にて2000kg/cm²の圧力で 1 時間等方加圧して、2 次試料を作製した。得られた高密度複合材料より、同様2×1×12mmの柱状試料を切り出し、その比重、電気抵抗(テスターによる)、磁気特性を

るため透磁率の周波数依存性は弱くなるが、 低密 度であるために飽和磁束密度及び透磁率の何れも が低かった。

これらの一次試料に対して、前述した3種類の処理を行った後、再度高圧焼結した試料は、いずれもより高密度化したが、一次成形密度が30%のもの以外は絶縁抵抗が低下した。その結果透極率の周波数依存性が顕緒になった。ところが、一次焼結密度が90パーセントのものでは、高密度化しても抵抗低下が認められず、そのために高周波数まで高い透磁率を示した。

比較のため、3種類の一次試料を無処理のまま 気密性容器に真空封入した後、上記と同一条件で Ar雰囲気下で1時間等方加圧して得た複合材料の 特性を測定した。いずれも電気抵抗が低下し、透 研事の周波数体存性が顕揚であった。

一般に金属粉体の表面が完全に絶縁体で覆われていても、これを加圧してほぼ100% 密度の成形体とする場合、金属粉体粒子の変形のため表面積の変化が生じて一部絶縁体質が存在しない部分が生

測定した。その結果を第3表に示した。

第3表

	比重	Ì	压坑	8 s =	3 5	五
(g/cm3)				μ (CGS)		
Хo	<b>-</b> ⋩	二次	Ω	k G	1 K H =	1882
1	5.37		> 2 0 M	8	230	2 4 0
2	6.34		> 2 0 M	10	670	570
3	6.75		1.0	1 1	1120	430
4	5.37	8.86	2.0	1.1	970	350
5	6.34	8.85	> 2 0 M	1.1	1020	970
6	6.75	6.85	< 0.1	1.1	1100	120
7	5.37	6.84	0.4	1.1	850	230
3	6.34	6.84	> 2 0 M	11	1060	990
9	6.75	6.88	< 0 . 1	.11	1080	110
0	5.37	6.77	2 K	11	690	470
1	8.34	6.79	> 2 0 M	11	1000	930
2	8.75	6.82	< 0 . 1	1.1	1140	70

#### \* 飽和硅東密度

第3より明らかなように、2度目の加圧処理を行わない試料No1~3では、高密度とする事により電気抵抗が低下し、より高密度である98パーセントの試料No3では、1kHzの透短率は高いが、1MHzの透磁率は1kHzの時の1/2以下に低下した。密度の低い試料No1及び2は、高抵抗であ

じる。 その結果金属粒子同士が直接接触して電気 抵抗が低下すると考えられるが、 試料No1~3 の結果より明らかなように、 絶縁破壊はかなり高 密度に ならないと生じない。 本実施例の方法では、 絶縁破壊が起こり易い部分のみの絶縁体の量を増 加させることなく、 高密度化と高絶縁性を保持 する事が可能となったものと考えられる。

発明者等は、本集的例に示した以外にも、が、本集的例に示けれているのでは、特件製を行ったが、の相対では、ないのではないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのではないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないのでは、ないの

めに望ましくない。

実施例17

第1の物質の平均在径約20μ mの A1金属粉末を、空気中で100℃に加熱し 2時間熱処理し、その表面に酸化膜を形成させ第1の物質以外に物質を粒子表面に形成した。膜の厚さを、熱処理時の重要増加、オージェ分光分析及びArスパッターによるデブスプロファイルにより評価したところ、約10mmであった。この粉末を成形し、金属A1パイプ中に真空状態で封じ、600℃に加熱し500kg/cm²の圧力で1時間、Arガスによる等方加圧を行い、一次焼結体を作製した。その相対密度は92パーセントであった。

この一次焼結体を、400℃で空気中2時間熱処理 した後、金属AIパイプ中に真空状態で封じ、600℃、 1000kg/cm²の圧力で3時間、Arガスによる等方加 圧を行い、二次焼結体を作製した。比較のため、 2度目の400℃での熱処理を行わない一次焼結体に 付いても同じ条件により二次成形体を作製した。

これらの二次成形体より、2×1×12mmの柱状試

だ構成され、この第1の物質以外の物質が第1の物質とは別の相でかつ建築相を形成し、しかも全体の気孔率が5%以下である複合材料であるので、気孔率が小さいことから強度は大幅に向上し、無機質が主体であることから耐熱性は非常に高い材料が得られる。

・また第1の物質と第1の物質以外の物質とが平均的に混合分散されている場合には両者の平均の様な特性が得られるが、本発明では、その特殊な構成により両者を掛け合わせた様な特性や、予型外の特異な性質が得られる。例えば39.9%金属でありながら絶縁体である特異な材料が合成されている。

更に第1の物質以外の物質を複数極用いるか、 追加して形成することにより、 拉界の誘電体層な どを緻密に形成でき、 さらに完全な第1の物質以 外の物質の層が完成する。

また、アルミの様に軽く、熱伝導性が良く、且つ、電気絶縁体である特異な性質を持つ材料、又、 高飽和磁束密度、高透磁率であり、耐摩耗性に後 料を切り出し、その比重、電気抵抗(テスターによる)及び熱伝導率を測定した。その結果、相対密度はどううも97%であったが、2度目の400℃での熱処理を行わなかった試料では、電気抵抗は50Ω程度と低かったのに対して、2度目の400℃での熱処理を行なった試料では20ΝΩ以上であった。またその熱伝導率は1801/ m・degであり、金属アルミニウムに近い値であった。

発明者等は、上記実施例以外にも極々の粉末粒径・粉末組成・鎮厚・鎮質で同様の実験を行ったが、やはり本発明の方法をとる事により、 従来得られていなかった優れた特性の複合材料を合成することが可能であった。

なお、 本発明の材料及びその製造方法は広く各種の材料に適用できることは云うまでもない。

発明の効果

本発明は、無機質で拉子状の第1の物質と、第 1の物質とは構成元素もしくは構成イオンの数、 種類あるいは価数又は結晶構造の内の何れかが異 なる第1の物質以外に物質との少なくとも2種額

れた複合金属材料等の従来実現されなかった材料が製造される。

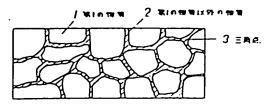
さらに、粒子状の第1の物質の量が多く、三角点の面積が少ないために強度は非常に高く、樹脂などの有機物を使用しない為に耐熱性も非常に高い、耐摩耗性の高い有用な材料が提供されている。

第1図、第2図及び第3図は本発明の複合材料の一例を示す断面部分拡大図、第4図及び第6図は本発明の複合材料の磁気特性図、第5図は本発明の複合材料の電気特性図、第7図は従来の複合・材料の構成を示す断面部分拡大図である。

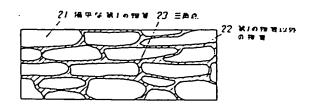
1, 11 ··· 第1の物質、2, 12, 22 ··· 第1の物質以外の物質、3, 13, 23 ··· 三角点、21 ··· 偏平な第1の物質。

代理人の氏名 弁理士 契野重孝 ほか1名

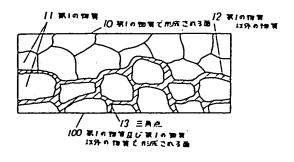
#### et 1 53



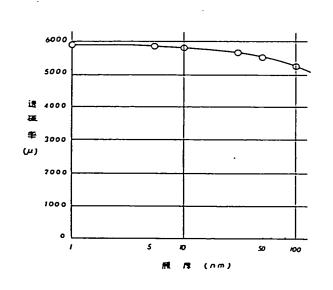
#### 第 3 歴

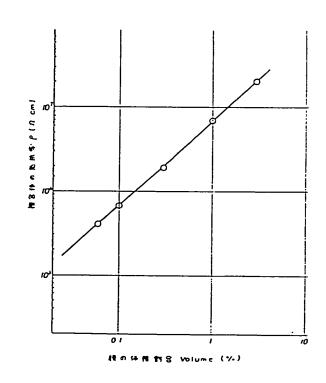


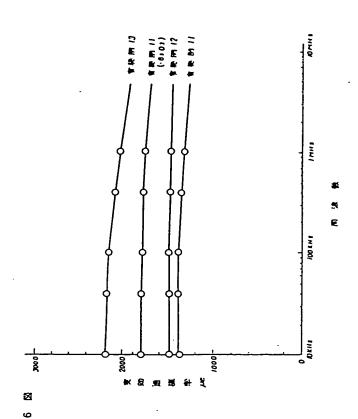
# 第 2 図

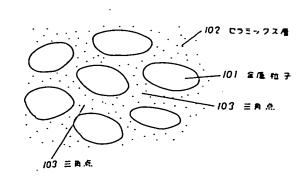


# 25 5 <u>1</u>21









第1頁の続き

⑤Int.Cl.	5	識別記号	庁内整理番号
B 22 F C 22 C H 01 F	3/14 1/04 38/00 1/24	304	A 8015-4K Z 7619-4K 7047-4K 7371-5E

優先権主張

②平1(1989)9月28日劉日本(JP)③特願 平1-253321 ②平1(1989)10月26日劉日本(JP)③特願 平1-280554 ②平1(1989)11月6日劉日本(JP)③特願 平1-288356 ②平1(1989)11月6日劉日本(JP)③特願 平1-288358 ②平1(1989)11月6日劉日本(JP)③特願 平1-288350 ②平1(1989)11月6日劉日本(JP)③特願 平1-288359 ②平2(1990)1月12日劉日本(JP)③特願 平2-4980 ②平2(1990)4月18日劉日本(JP)③特願 平2-101934 ②平2(1990)3月26日劉日本(JP)③特願 平2-76062